

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2002-373862

(P 2 0 0 2 - 3 7 3 8 6 2 A)

(43) 公開日 平成14年12月26日 (2002.12.26)

(51) Int. Cl. 7

H01L 21/205

21/68

H05B 3/10

3/20

識別記号

F I

テマコード (参考)

H01L 21/205

3K034

21/68

R 3K092

H05B 3/10

A 5F031

C 5F045

393

3/20

393

審査請求 未請求 請求項の数 7 O L (全 9 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号

特願2001-180963 (P 2001-180963)

(22) 出願日

平成13年6月15日 (2001.6.15)

(71) 出願人 000004547

日本特殊陶業株式会社

愛知県名古屋市瑞穂区高辻町14番18号

(72) 発明者 森田 直年

愛知県名古屋市瑞穂区高辻町14番18号 日

本特殊陶業株式会社内

(72) 発明者 坂井 茂仁

愛知県名古屋市瑞穂区高辻町14番18号 日

本特殊陶業株式会社内

(74) 代理人 100098567

弁理士 加藤 壮祐

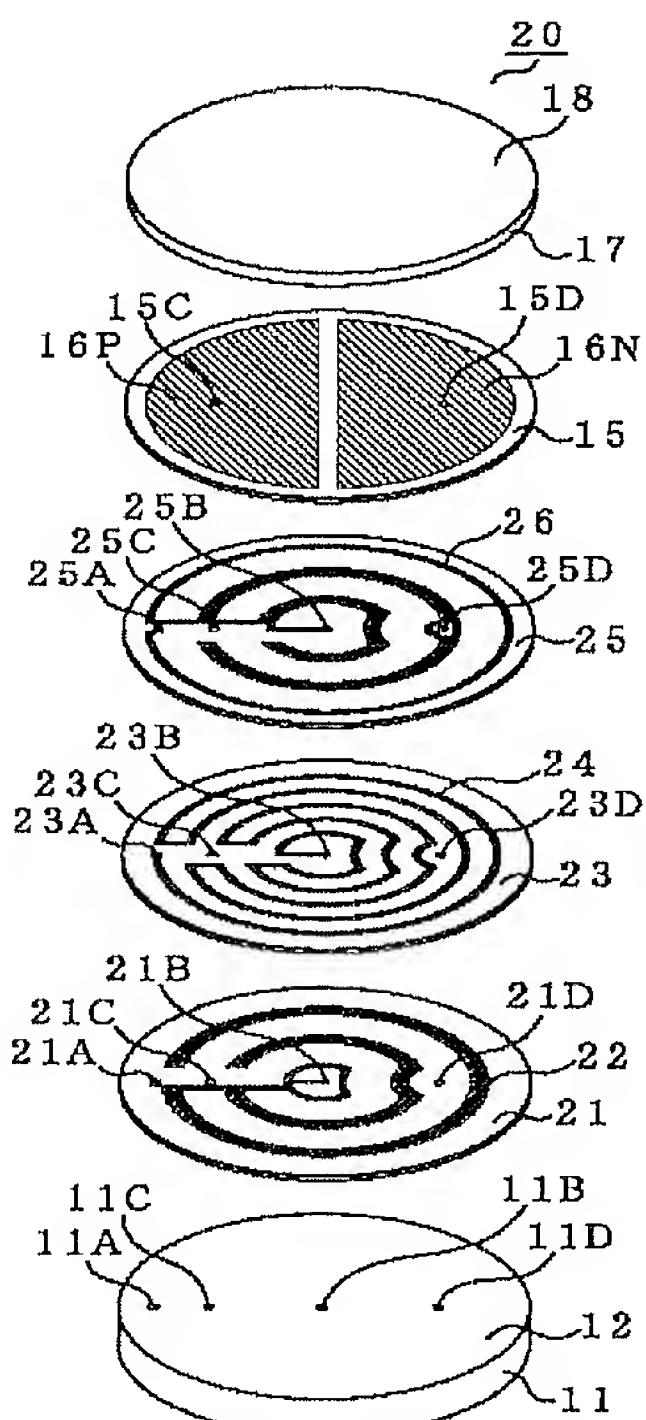
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】セラミックヒータ

(57) 【要約】

【課題】ウエハを吸着する吸着面の温度分布の小さい安価なセラミックヒータを提供する。

【解決手段】ヒータパターン22, 24, 26及びグリーンシート21, 23, 25からなるヒータ層を複数層設けるようにした。



【特許請求の範囲】

【請求項 1】 アルミナ、ムライト、マグネシア、窒化アルミニウム、窒化珪素等からなるセラミックヒータ体と、前記セラミックヒータ体の内部に埋設された抵抗発熱体とを備え、前記セラミックヒータ体の一方の面に被加工物たるウエハを吸着可能な吸着面が形成されていること、を特徴とするセラミックヒータにおいて、前記セラミックヒータ体が複数層のセラミックスのグリーンシートを積層して構成された部分を有し、

前記抵抗発熱体が前記グリーンシート上にスクリーン印刷法により形成されメタライズされたヒータパターンであり、

前記ヒータパターン及びグリーンシートからなるヒータ層が複数層あること、を特徴とするセラミックヒータ。

【請求項 2】 前記複数層のヒータ層のヒータパターンが、電気的に並列に接続されていることを特徴とする請求項 1 記載のセラミックヒータ。

【請求項 3】 前記複数層のヒータ層のヒータパターンが、前記吸着面の上方から見て重ならないように配置されていることを特徴とする請求項 1 または 2 に記載のセラミックヒータ。

【請求項 4】 前記重ならないように配置されたヒータパターンの全面積が、前記吸着面の面積の 2/3 以上であることを特徴とする請求項 3 記載のセラミックヒータ。

【請求項 5】 前記重ならないように配置されたヒータパターンの全面積が、前記吸着面の全面積と略等しいことを特徴とする請求項 3 記載のセラミックヒータ。

【請求項 6】 前記セラミックヒータ体の内部で前記吸着面の近傍に、電圧を印加可能な膜状静電吸着パターンが形成されていることを特徴とする請求項 1 乃至 5 に記載のセラミックヒータ。

【請求項 7】 前記グリーンシートがアルミナにより構成されていることを特徴とする請求項 1 乃至 6 に記載のセラミックヒータ。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は、半導体製造装置に関し、特に、シリコンウエハ等に化学蒸着 (CVD Chemical vapor deposition) 、プラズマエッティング、スパッタリング等を施す際にウエハを加熱しながら保持するのに好適なセラミックヒータに関する。

【0002】

【従来の技術】 LSI 等の半導体製造装置では、ウエハを保持するのにクーロン力あるいはジョンソンラーベック効果 (Johnson Rahbeck effect) を用いた静電吸着手段が多く用いられる。この静電吸着手段には、単にウエハを保持する機能のみならず、過酷な環境下でウエハの温度を均一に保持するという機能、チャンバー内を汚染 (コンタミネーション) しない機能、過酷な雰囲気下

での使用に耐える機能も求められる。この種のウエハ保持装置、加熱装置として特許第 2521471 号公報、特開 2000-348853 号公報、特公平 7-50736 号公報等が開示されている。

【0003】 上記第 1 の特許公報では、金属ベース板 1 と焼結セラミック板 6 との間に弾性絶縁体 3 を介在させてその弾性変形により、焼結セラミック板 6 に掛かる熱応力を緩和しようとしたものである (公報の第 1 図参照)。

【0004】 上記第 2 の公開公報では、窒化アルミニウムからなる基体 2 と同じく窒化アルミニウムからなる被覆板 3 との間に、添加剤を含まない炭化珪素からなるヒータエレメント 8 を介在させたものが開示されている (公報の図 1 参照)。同じような熱膨張係数を有する材料を組み合わせることにより熱衝撃を緩和し、耐久性を向上させると共に耐汚染性を向上させようとしたものである。

【0005】 上記第 3 の公告公報では、被加工物であるウエハと熱膨張率の近似した窒化珪素、窒化アルミニウム、サイロン等からなる基体 2A と誘電体層 4A とを主要な要素とし、基体 2A と誘電体層 4A との間に静電チャッカの機能を果たす膜状電極 5A を配置し、基体 2A 内にタングステン線からなる抵抗発熱体 3 を埋設したものが開示されている (公報の図 3 参照)。基体 2A および誘電体層 4A が上記のようなセラミックスからなっているので高温に耐え、500°C にも達する熱 CVD 装置にも使用できるようにしたのである。また、誘電体層 4A の表面を研磨加工し平面度を上げることによりウエハを吸着したときの密着性を高め、ウエハ全面に亘っての均一な加熱を可能としたものである。

【0006】

【発明が解決しようとする課題】 しかしながら、上記第 1 の特許公報に記載のものは、温度の変化に応じてシリコンゴムからなる弾性絶縁体膜 3 が伸縮するため、弾性絶縁体膜 3 の寿命が問題になり耐久性に乏しいという問題点がある。また、金属ベース板 1 からウエハ 11 までに介在する板 6、5、7、3 の厚さが薄いことから高温には耐えられないものと推定される。

【0007】 また、上記第 2 の公開公報に記載のものは、製品としては優れた機能を発揮するものの、窒化アルミニウムからなる基体 1、被覆板 3、炭化珪素からなるヒータエレメント 8 といった複雑な形状をなすものをホットプレス法により製作しなければならない。このため、コスト高になるという問題点がある。

【0008】 さらに、上記第 3 の公告公報に記載のものは、フランジ部 4b を設けたことから製品としてはさらに優れた機能を発揮するものの、タングステンからなる螺旋状の抵抗発熱体 3 を埋設した窒化珪素からなる基体 2A、セラミックス誘電体層 4A 等をホットプレス法により製作しなければならない。このため、コスト高にな

るという問題点がある。

【0009】半導体製造装置、なかでもCVD装置に用いられるセラミックヒータにはウエハを均一に加熱する機能が要求される。そのため、セラミックヒータの加熱面の面内温度分布が±5%以下（できれば±1%以下）になるよう抑える必要がある。面内温度分布を小さく抑えるための一つの方法は、セラミックヒータ全体の厚さを厚くして熱容量を大きくし、面内温度分布を均一化することである。上記第2及び第3の公報に記載のものは基体1, 2Aの厚さを1.5mm以上に設定している。

【0010】このように厚いセラミック製品を製造するにはホットプレス法、熱間静水圧プレス法が用いられる。この方法は均一な圧力を加えながら焼成する方法であるので製造装置が大がかりになり、コストアップの大きな要因になる。また、ホットプレス法ではスクリーン印刷法による導電部の形成ができないので、セラミックヒータ体に内蔵される抵抗発熱体や膜状静電吸着パターンのパターンが複雑であると極端にコストアップする。一方、スクリーン印刷が導入可能なシート積層法では5mm以下の厚さのものしか製造できない。

【0011】また、安価に形成できるスクリーン印刷によるヒータパターンは、印刷されるセラミックグリーンシートの面積の1/3程度の面積しか形成できない。これ以上の面積に印刷によりヒータパターンを形成しようとすると、ヒーターパターンの厚さが均一にならない等、種々の技術的な困難が生じてくる。このため、従来の印刷によるヒータパターンでは、ウエハを加熱する加熱面の高々1/3程度の面積にしかヒータパターンを配置することができなかった。このため、加熱面の温度分布を均一にするのが難しいという問題点があった。

【0012】また、CVD装置に用いられるセラミックヒータは半導体製造装置の寿命の間使い続けられるものではなく、その過酷な雰囲気条件から数ヶ月毎に新品と交換しなければならない消耗品である。このため、この種のセラミックヒータにはコストダウンが特に求められている。

【0013】そこで、本発明は、ウエハを保持すると共にウエハを均一に加熱することのできる安価なセラミックヒータを提供することを目的とする。

【0014】

【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するための手段について、例示として図3を参照し説明する。本発明のうち請求項1記載の発明は、アルミナ、ムライト、マグネシア、窒化アルミニウム、窒化珪素等からなるセラミックヒータ体20と、前記セラミックヒータ体20の内部に埋設された抵抗発熱体22, 24, 26とを備え、前記セラミックヒータ体20の一方の面に被加工物たるウエハを吸着可能な吸着面18が形成されていること、を特徴とするセラミックヒータにおいて、前記セラミックヒータ体20が複数層のセラミックスのグリ

ーンシート21, 23, 25を積層して構成された部分を有し、前記抵抗発熱体が前記グリーンシート上にスクリーン印刷法により形成されメタライズされたヒータパターン22, 24, 26であり、前記ヒータパターン及びグリーンシートからなるヒータ層21, 23, 25が複数層であること、を特徴とする。

【0015】1枚のグリーンシート上にスクリーン印刷法で形成できるヒートパターンの面積は技術上の問題から1/3以下に限られる。しかし、このようにヒータ層21, 23, 25を複数層形成すると、吸着面18直下のより多くの面積にヒータパターン22, 24, 26を形成することができ吸着面18の温度をより均一化することができる。

【0016】ここで、請求項2記載の発明のように、前記複数層のヒータ層21, 23, 25のヒータパターン22, 24, 25が、電気的に並列に接続されていることを特徴とすることができる。一般にメタライズにより形成されたヒータパターンは正の温度抵抗係数を有する。これを電気的に直列に接続したとすると、一部のヒータパターンの温度が上昇すると温度の上昇に比例して抵抗値Rが上昇し、発熱量は I^2R に比例するからさらにその部分の発熱量が上昇して、一部のヒーターパターンのみが過熱して吸着面18の温度分布が大きくなる。上記のように形成すると、一部のヒーターパターンの温度が上昇するとそのヒーターパターンの抵抗値Rが上昇し流れる電流が減少するから発熱量が減少し、各ヒーターパターン22, 24, 26の温度が平準化する。このため、吸着面18の温度分布を小さくすることができるという効果を奏する。

【0017】ここで、請求項3記載の発明のように、前記複数層のヒータ層21, 23, 25のヒータパターン22, 24, 26が、前記吸着面18の上方から見て重ならないように配置されていることを特徴とすることができる。このように形成すると、吸着面18の温度分布をより小さくできる。

【0018】ここで、請求項4記載の発明のように、前記重ならないように配置されたヒータパターン22, 24, 26の全面積が、前記吸着面18の面積の2/3以上であることを特徴とすることができる。このように形成すると、吸着面18直下の多くの面積がヒーターパターン22, 24, 26で覆われることになり、吸着面の温度分布を小さくできる。

【0019】ここで、請求項5記載の発明のように、前記重ならないように配置されたヒータパターン22, 24, 26の全面積が、前記吸着面18の全面積と略等しいことを特徴とすることができる。このように形成すると、吸着面18の直下に必ず発熱体であるヒーターパターン22, 24, 26が存在することになり、吸着面18の温度分布をより小さくできる。

【0020】ここで、請求項6記載の発明のように、前

記セラミックヒータ体(20)の内部で前記吸着面18の近傍に、電圧を印加可能な膜状静電吸着パターン16P、16Nが形成されていることを特徴とすることができる。このように形成すると、膜状静電吸着パターン16P、16Nに高電圧を印加することにより、吸着面18上に載置したウエハをクーロン力あるいはジョンソンラーベック効果による吸引力によりセラミックヒータ20に強く吸着することができる。

【0021】ここで、請求項7記載の発明のように、前記グリーンシート21、23、25がアルミナにより構成されていることを特徴とすることができる。このように形成すると、比較的安価にセラミックヒータを提供することができる。また、耐熱性はアルミナで十分である。

【0022】

【発明の実施の形態】本発明の第1の実施の形態について図面を参照し説明する。図1は第1の実施の形態に係るセラミックヒータ10の製造工程を説明する分解斜視図である。セラミックヒータ10は主な要素として、図面下から、セラミック基体11、第1のグリーンシート13、第2のグリーンシート15、セラミック吸着面体17からなる。各部材11、13、15、17は円板形状をなし、その直径は、たとえば8インチのウエハを載置するものでは205mm程度である。板厚は全体で20mm程度の板厚になるように選択される。

【0023】セラミック基体11は高純度のセラミック粉末をプレス成形して作る。たとえば、99.9%以上の高純度のアルミナ粉末をプレス加工して形成する。このとき、端子用に4つのスルーホール11A、11B、11C、11Dを形成しておく。セラミック吸着面体17も同様に高純度のアルミナ粉末をプレス加工して形成する。プレス加工するときの圧力はプレス品11、17の割掛け率がグリーンシート13、15のそれと一致するように調整する。

【0024】グリーンシート13、15は次のようにして作る。まず、アルミナ粉末に、酸化マグネシウムMgOを1wt% (重量比、以下同じ)、酸化珪素(シリカ)SiO₂を4wt%、を混合してボールミルで50~80時間湿式粉碎した後、脱水乾燥する。この粉末に、メタクリル酸イソブチルエステルを3wt%、ブチルエステルを3wt%、ニトロセルロースを1wt%、ジオクチルフタレートを0.5wt%加え、さらに、溶剤として、トリクロールエチレン、n-ブタノールを加えてボールミルで混合し流動性のあるスラリーとする。

(以下、このスラリーをアルミナスラリーと呼ぶ)。このアルミナスラリーを減圧脱泡後、平板状に流し出して徐冷し、溶剤を発散させて厚さ0.8mmのアルミナグリーンシートを形成する。アルミナグリーンシートには絶縁抵抗を下げる目的で、モリブデンMo、チタンTi等の金属粉末を添加することがある。

10

20

30

40

50

【0025】グリーンシート上に印刷するメタライズインクは、上記アルミナスラリーを作ると同様の方法により、タンクスチーン(W)粉末を混ぜてスラリー状としメタライズインクとする。厚さ0.8mmの第1のグリーンシート13の上に通常のスクリーン印刷法を用いて渦巻き形状をしたヒータパターン(抵抗発熱体)14を形成する。その上に厚さ0.8mmの第2のグリーンシート15を載置する。第2のグリーンシート15の上に通常のスクリーン印刷法を用いて2つの膜状静電吸着パターン16P、16Nを形成する。さらに、その上に図示しない厚さ0.8mmの第3のグリーンシートを載せ、熱圧着して一枚のシートとする。このとき、各スルーホール13A、13B、13C、13D、15C、15Dにメタライズインクを充填しておく。熱圧着したシートはマシニング等の機械加工により直径205mmの円板形状にする。

【0026】この熱圧着した薄いシート13、15をセラミック基体11およびセラミック吸着面体17で挟み接着して一体にする。すなわち、セラミック基体11の上面に前記アルミナスラリーを塗布しペースト面12を作り、熱圧着したシート13、15を接着する。シート13、15の上面にもアルミナスラリーを塗布し、セラミック吸着面体17を接着する。また、各スルーホール11A、11B、11C、11Dにメタライズインクを充填しておく。次に、この接合したものを、水素ガス等の還元雰囲気にて1400~1600°Cにて一体焼成する。そして、焼成したもののセラミック吸着面体17の表面を、研磨し平面度が30ミクロン以下(好ましくは10ミクロン以下)の平面となるようにしてウエハの吸着面18とする。

【0027】図2はこのようにして形成されたセラミックヒータ10を下から見た斜視図である。スルーホール11A、11B、11C、11Dに充填されたメタライズインクが焼成してできた端子部分にニッケルメッキを施し、さらにニッケルピンをロウ付けして端子11A'、11B'、11C'、11D'とする。端子11A'、11B'は、それぞれスルーホール11A、13A及びスルーホール11B、13Bを経由してヒータパターン14の外側端及び中心端に接続される。端子11C'、11D'は、それぞれスルーホール11C、13C及びスルーホール11D、13Dを経由して膜状静電吸着パターン16Pまたは16Nにそれぞれ電気的に接続される。

【0028】このようにして形成されたセラミックヒータ10の本体部分を占めるセラミック本体は、アルミナの組成が99.9%を占める純度の高い層(セラミック基体11、セラミック吸着面体17)と、アルミナの組成が92%程度の純度の比較的低い層(第1、第2のグリーンシート13、15、第3のグリーンシート)との多層構造をなす。純度の低い層の厚さは2.4mm程度

であり、純度の高い層の厚さは合わせて 15 mm を超える。

【0029】以上の構成に基づき、作動について説明する。端子 11A'、11B' に電圧を印加すると渦巻き形状のヒータパターン 14 に電流が流れ、セラミックヒータ 10 のセラミックヒータ体が加熱され、たとえば吸着面 18 が 500°C に加熱される。また、端子 11C'、11D' に高電圧を、たとえば、端子 11C' には +1 kV を、端子 11D' には -1 kV を印加することにより、端子 11C' の電圧はスルーホール 13C、15C を経由して膜状静電吸着パターン 16P に +1 kV が印加され、端子 11D' の電圧はスルーホール 13D、15D を経由して膜状静電吸着パターン 16N に -1 kV が印加される。被加工物であるシリコンウエハはセラミックヒータ 10 の吸着面 18 の上に載置され吸着される。このとき、吸着面 18 の近傍にある膜状静電吸着パターン 16P、16N に高電圧が印加されるから誘電体であるシリコンウエハにも電荷が誘起され、クーロン力によりシリコンウエハは吸着面 18 に吸引される。

【0030】本実施の形態の利点について説明する。セラミックヒータ体 (10) の厚さが 15 mm 以上と厚いので吸着面 18 の温度分布が均一化し、ウエハを吸着する吸着面 18 の面内温度分布を小さく抑えることができる。また、セラミック純度の高い層 11、17 がセラミックヒータ 10 の表面積の大部分を占めるから、セラミックヒータ 10 からのコンタミネーションを小さく抑えることができる。さらに、吸着面 18 を構成する層であるセラミック吸着面体 17 の純度が高いので、吸着面 18 に接触するシリコンウエハがシリカ等の付着により汚損されることが無く、コンタミネーションに強い。さらに、セラミックヒータ体 (10) を構成する各層 11、13、15、17 がアルミナで構成されているから、十分耐熱性のあるセラミックヒータ 10 を安価に提供することができる。

【0031】本実施の形態では、膜状静電吸着パターン 16P、16N の正極 16P と負極 16N との面積が同じ程度になるようにしたが、正極の膜状静電吸着パターン 16P と負極の膜状静電吸着パターン 16N の面積を大きく異ならせるようにしても良い。この様にすると、実験的にではあるが、シリコンウエハの吸着力をより強くすることができた。

【0032】本実施の形態ではセラミックとしてアルミナを用いたが、この他の種々のセラミック、たとえば、マグネシア、ムライト等を用いてもよい。

【0033】図 3 は第 2 の実施の形態に係るセラミックヒータ 20 の製造工程を説明する分解斜視図である。図 1 で説明したセラミックヒータ 10 と異なるのは、抵抗発熱体となるヒータパターンが一層ではなく三層に形成されている点である。図 1 と同じ部材には同じ符号を付して理解を容易にした。セラミックヒータ 20 は主な要

素として、図面下から、セラミック基体 11、第 1 のヒータパターン 22 用の第 1 のグリーンシート 21、第 2 のヒータパターン 24 用の第 2 のグリーンシート 23、第 3 のヒータパターン 26 用の第 3 のグリーンシート 25、吸着パターン 16P、16N 用の第 4 のグリーンシート 15、セラミック吸着面体 17 からなる。

【0034】セラミック基体 11 とセラミック吸着面体 17 は高純度のアルミナ粉末をプレス成形して作ることは段落番号 [0023] で説明したのと同じである。第 1 乃至第 4 のグリーンシート 21、23、25、15 を作る方法は段落番号 [0024] で述べたのと同じである。グリーンシート 21、23、25、15 上にそれぞれヒータパターン 22、23、25 や膜状静電吸着パターン 16P、16N を形成し熱圧着することや、熱圧着したシートをセラミック基体 11 とセラミック吸着面体 17 で挟みアルミナスラリーで接着して一体に焼成することは段落番号 [0025]、[0026] に記載した内容と同じである。

【0035】第 1、第 2、第 3 のグリーンシート 21、23、25 上にはそれぞれ異なった形状のヒータパターン 22、24、26 がタンクステン (W) メタライズインクによるスクリーン印刷法により形成される。各ヒータパターン 22、24、26 は異なった模様を描くものの、グリーンシートの外側端にあるスルーホール 21A、23A、25A から始まって中心にあるスルーホール 21B、23B、25B に至る一筆書きのパターンを形成している。外側端にあるスルーホール 21A、23A、25A はセラミック基体 11 の外側のスルーホール 11A に、中心のスルーホール 21B、23B、25B はセラミック基体 11 の中心のスルーホール 11B に、それぞれメタライズインクを充填されることにより接続されるから、上記 3 つのヒータパターン 22、24、26 は電気的に並列に接続されることになる。

【0036】また、3 つのグリーンシート 21、23、25 の層の上の各ヒータパターン 22、24、26 は、出発点と終点との近傍を除き、吸着面 18 の上から見て重ならないように形成されている。図 4 は吸着面 18 の上から透視して各ヒータパターン 22、24、26 を見た状態を示す仮想的な平面図である。ヒータパターン 22、24、26 にはそれぞれ異なったハッチングを施して識別できるようにしているが、それでもヒータパターンが見づらいので容赦されたい。セラミック基体 11 の外縁付近にあるスルーホール 11A から出発するヒータパターンは、最外周のヒータパターン 26 (第 3 のグリーンシート 25 上) と、その内側のヒータパターン 24 (第 2 のグリーンシート 23 上) と、最内周のヒータパターン 22 (第 1 のグリーンシート上) との 3 つのヒータパターンに分岐する。各ヒータパターン 22、24、26 は、図 3 に示すように、独自の螺旋模様を描いてセラミック基体 11 の中心付近に集まる。中心付近に集ま

った各ヒータパターン 22, 24, 26 は中心のスルーホール 11B で一つになる。スルーホール 11C, 11D は膜状静電吸着パターン 16P, 16N に接続するためのものである。

【0037】ここでは、3つのヒータパターン 22, 24, 26 が電気的に並列に接続されていることと、3つのヒータパターン 22, 24, 26 により吸着面 18 の全面積が殆ど覆われていることに注意されたい。

【0038】本実施の形態の利点について説明する。3層のヒータ層（グリーンシート 21, 23, 25）のヒータパターン 22, 24, 26 が電気的に並列に接続されているから、各ヒータパターン 22, 24, 26 の発熱が平準化し、一部のヒータパターンのみが過熱する事がない。これは、ヒータパターンを構成するタンクスデン（W）メタライズが正の温度抵抗係数を有するため、もし仮に直列に接続したとすると、一部のヒータパターンの温度が上昇すると温度の上昇に比例して抵抗値 R が上昇し、発熱量は $I^2 R$ に比例するからさらに発熱量が上昇して、一部のヒータパターンのみが過熱することになる。本実施の形態ではヒータパターンが並列に接続されているから、この様なことは起こり得ない。一部のヒータパターンの温度が上昇すると温度の上昇に比例して抵抗値 R が上昇し、そのヒータパターンを流れる電流が減少するため発熱量が低下する。このため各ヒータパターン 22, 24, 26 の発熱量が平準化し、結果として、吸着面 18 の温度分布が均一化することになる。

【0039】さらに、3つのヒータパターン 22, 24, 26 により吸着面 18 の全面積が殆ど覆われているから、吸着面 18 の直下にヒータパターンが必ずあることになり、吸着面 18 の温度分布の均一化がさらに容易になることになる。

【0040】考えとしては、一つのヒータパターンで吸着面 18 の直下を全て覆うパターンを考えられないわけではないが、スクリーン印刷でメタライズされたヒータパターンをグリーンシートの面積の 1/3 以上の面積に作成することは技術的な困難を伴う。したがって、本実施の形態のようにヒータパターンを 3 分割し、それぞれ異なるグリーンシート上にヒータパターンを形成するのが実用的に優れている。

【0041】また、本実施の形態は、図 3 に示すように、膜状静電吸着パターン 16P, 16N を備えているから、段落番号【0029】で述べたように、両パターン 16P, 16N に高電圧を印加することにより、吸着面 18 に載置したシリコンウェハを吸引することができる。さらに、各グリーンシート 21, 23, 25, 15 がアルミナで構成されているから、十分耐熱性のあるセラミックヒータ 20 を安価に提供することができる。

【0042】図 5 は第 3 の実施の形態に係るセラミックヒータ 30 を示す断面図であり、図 6 は図 5 の X 方向矢視図（平面図）である。このセラミックヒータ 30 は、

図 1 で示したセラミックヒータ体（セラミックヒータ）10 を円筒形状の支持体 32 で支承し一体化したものである。セラミックヒータ体 10 は図 1 で説明したように内部にヒータパターン（抵抗発熱体）14 及び膜状静電吸着パターン 16P, 16N を備えている。円板形状のセラミックヒータ体 10 の上には熱伝導度の高い窒化アルミニウムからなるセラミック板 33 が密着して設置される。円板形状のセラミックヒータ体 10 はその周縁を円筒形状の支持体 32 のつば部 32A に支承されている。円筒形状の支持体 32 はアルミナセラミックにより構成されている。支持体 32 は、その底部を半導体製造装置の取り付け部 31 に固定される。セラミックヒータ 30 はその周りを半導体製造装置の筐体 51 で囲われ高真空のチャンバー 50 を構成する、セラミックヒータ体 10 の下方で支持体 32 の円筒部に囲まれた空間は大気圧にされ、空気断熱層 40 を構成している。

【0043】図 6 はセラミックヒータ 30 の平面図である。支持体 32 には内周方向に突出した位置決め用のノッチ 35 が一体に形成され、セラミックヒータ体 10 及びセラミック板 33 にはノッチ 35 に対応した凹部が形成され、支持体 32 に対するセラミックヒータ体 10 及びセラミック板 33 の位置決めを正確に行うようにされている。

【0044】このような支持体 32 とセラミックヒータ体 10 とが一体となったセラミックヒータ 30 を製造するには 2 つの方法がある。第 1 の方法は焼成前のセラミックヒータ体 10 と支持体 32 とをセラミックスラリーで接合し、一体に焼成してしまう方法である。第 2 の方法は支持体 32 とセラミックヒータ体 10 とをそれぞれ別個に焼成し、焼成したものをそれぞれ研磨して寸法精度を確保して組み合わせる方法である。

【0045】第 1 の方法について説明する。セラミックヒータ体 10 の中間品は段落番号【0023】、【0024】、【0025】で述べたようにして製作する。また、支持体 32 は、アルミナ粉末に、酸化マグネシウム MgO を 1 wt % (重量比、以下同じ)、酸化珪素 (シリカ) SiO₂ を 4 wt %、を混合してボールミルで 50 ~ 80 時間湿式粉碎した後、脱水乾燥する。この粉末をプレス加工により円筒形状に成形する。つぎに、段落番号【0024】で述べたアルミナスラリーを、セラミックヒータ体 10 (シート形成品) と支持体 32 (プレス形成品) との間に塗布し、接着する。そして、接着したものを還元雰囲気にて、1400 ~ 1600 °C にて一体に焼成する。焼成したものは、セラミックヒータ体 10 の吸着面 18 の平面度が 30 ミクロン以下となるように研磨する。次に、スルーホール 11A, 11B, 11C, 11D に充填されたメタライズインクが焼成してできた端子部分にニッケルメッキを施し、さらにニッケルピンをロウ付けして端子 11A', 11B', 11C', 11D' とする。最後に、シリコンウェハの載置

面の温度分布が均一になるように、図5に示すように、窒化アルミニウムからなるセラミック板33を載置する。

【0046】第2の方法について説明する。セラミックヒータ体10は段落番号【0023】、【0024】、【0025】【0026】で述べたようにして焼成して製作する。そして、焼成したセラミックヒータ体10の外筒研磨を行い、外形寸法精度を確保する。また、そのとき、位置決め用のノッチ35に嵌合する凹部も研磨により設ける。支持体32は、段落番号【0045】で述べたようにして円筒形状のプレス成形品を作る。この円筒形状のプレス成形品を大気中にて焼成し、円筒形状のセラミック成形体を得る。この焼成したセラミック成形体の、セラミックヒータ体10が載置される部分(つば部32A近傍)の内筒研磨を行い、内径寸法精度を確保する。また、そのとき、位置決め用のノッチ35の凸部も研磨により設ける。そして、位置決め用のノッチ35の凹凸を合わせて、セラミックヒータ体10と支持体32を一体に組み込む。

【0047】セラミックヒータ体10の吸着面18の温度分布の均一さを確保する目的で、熱伝導度の高い窒化アルミニウムからなるセラミック板33をセラミックヒータ体10の上面または下面に載置する。このとき、窒化アルミニウムからなるセラミック板33にもセラミックヒータ体10と同様に位置決め用のノッチ35と係合する凹部を研磨により設けておく。また、温度分布をさらに均一にする目的で、セラミックヒータ体10の吸着面18とセラミック板33の接触面は、研磨して平面度を向上させ接触率を上げることが好ましい。

【0048】上記の例では円筒形状の支持体32をアルミナのプレス成形品で構成したが、支持体の本体を金属で作成し、その金属体の上にアルミナ等のセラミックを溶射して表面を絶縁物としたものにしても良い。

【0049】本実施の形態の利点について説明する。円筒形状の支持体32によりセラミックヒータ体10が支持されているから、高温になるセラミックヒータ体10の吸着面18から低温の装置の取り付け部31までの距

離を稼ぐことができ、セラミックヒータ体10の厚さ方向の温度勾配を緩和することができる。このため熱膨張差による熱応力を大幅に緩和することができ、セラミックヒータ30の信頼性が大幅に向上した。

【図面の簡単な説明】

【図1】第1の実施の形態に係るセラミックヒータの製造工程を説明する分解斜視図である。

【図2】第1の実施の形態に係るセラミックヒータを下から見た斜視図である。

【図3】第2の実施の形態に係るセラミックヒータの製造工程を説明する分解斜視図である。

【図4】吸着面の上から透視して各ヒータパターンを見た状態を示す仮想的な平面図である。

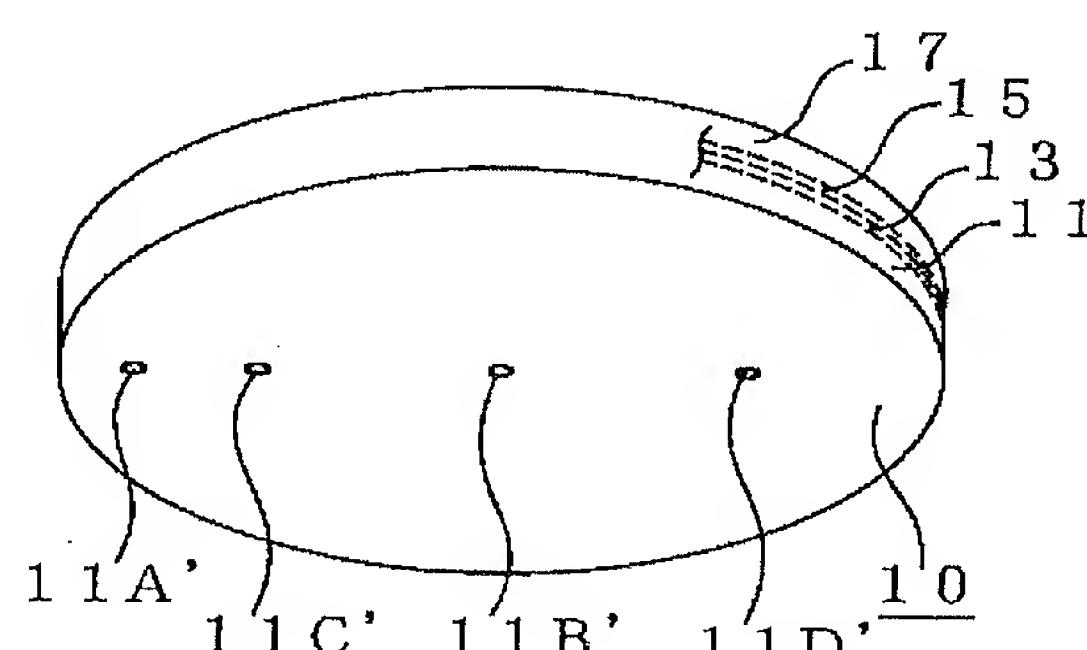
【図5】第3の実施の形態に係るセラミックヒータを示す断面図である。

【図6】図5のX方向矢視図であり平面図である。

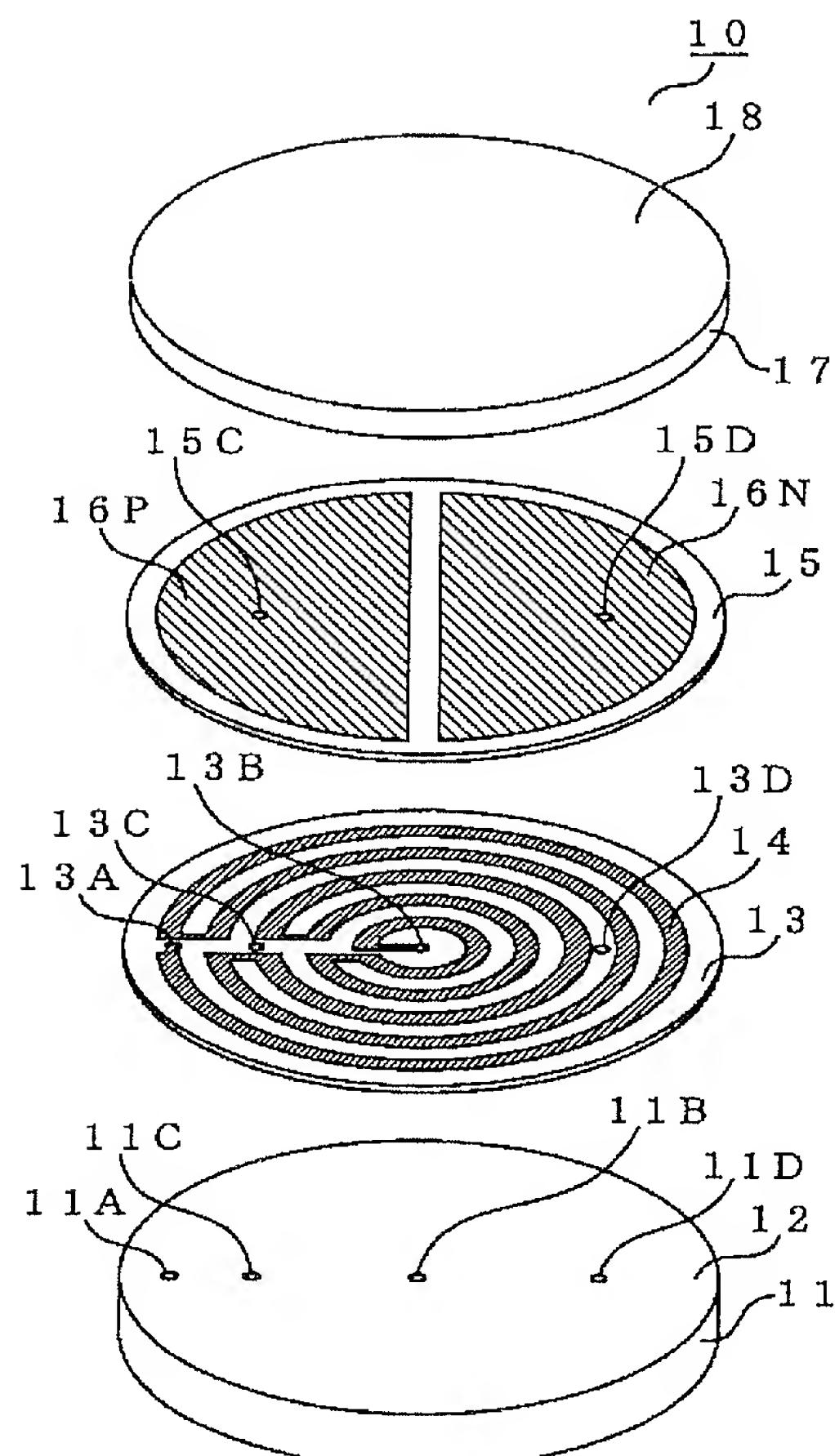
【符号の説明】

10	セラミックヒータ(セラミックヒータ体)
11	セラミック基体
13	第1のグリーンシート
14	ヒータパターン(抵抗発熱体)
15	第2のグリーンシート
16P、16N	膜状静電吸着パターン
17	セラミック吸着面体
18	吸着面
21	第1のグリーンシート
22	第1のヒータパターン
23	第2のグリーンシート
24	第2のヒータパターン
25	第3のグリーンシート
26	第3のヒータパターン
31	取り付け部
32	支持体
33	セラミック板
35	ノッチ
40	空気断熱層

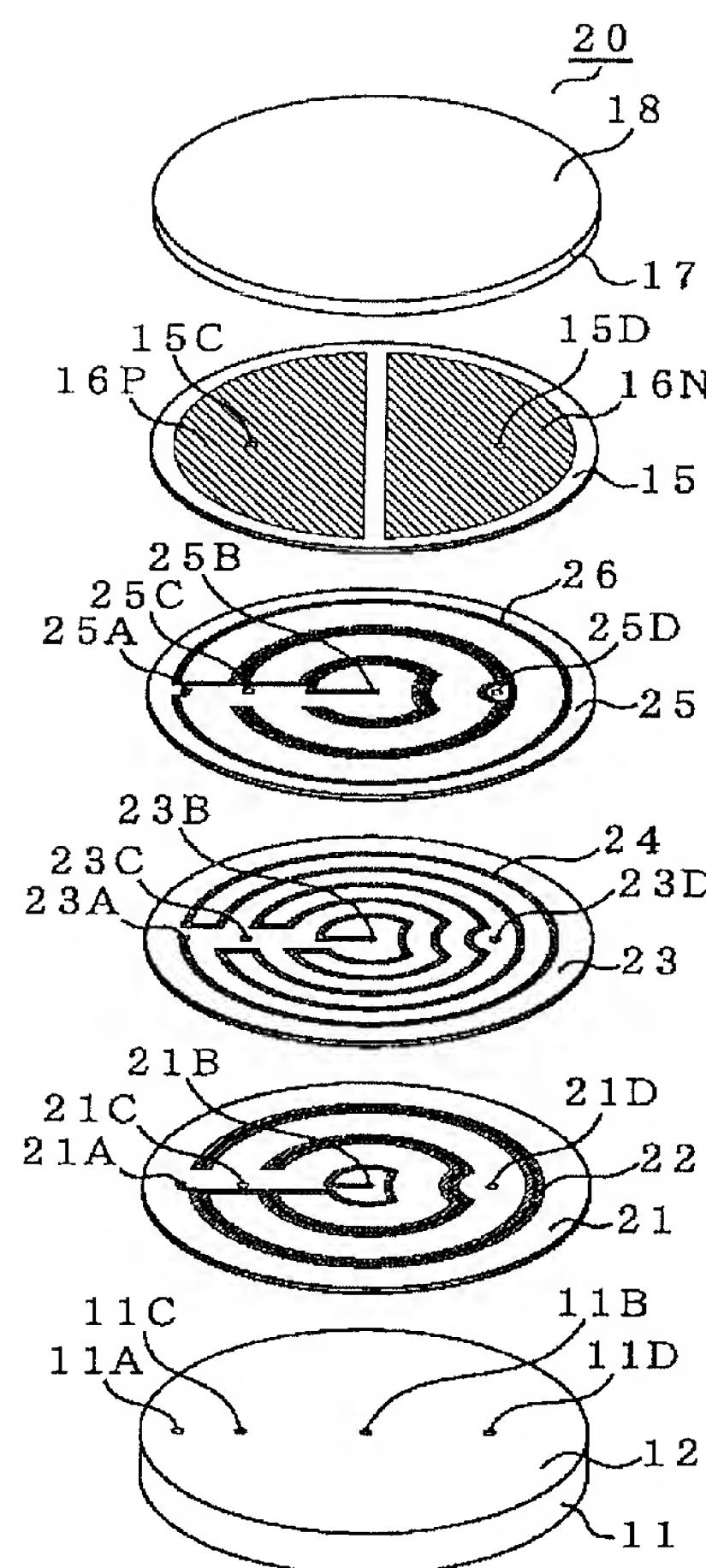
【図2】



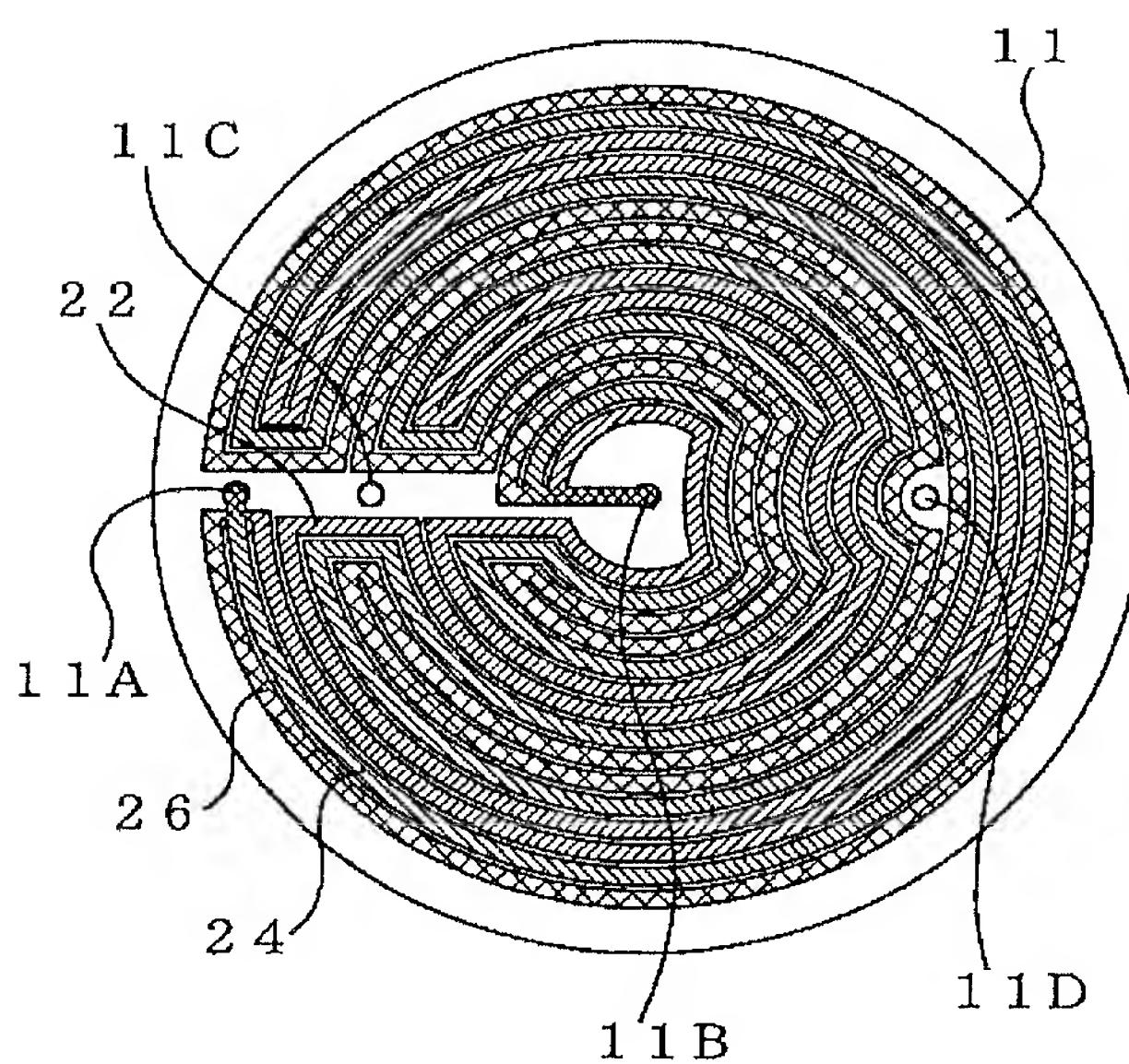
【図 1】



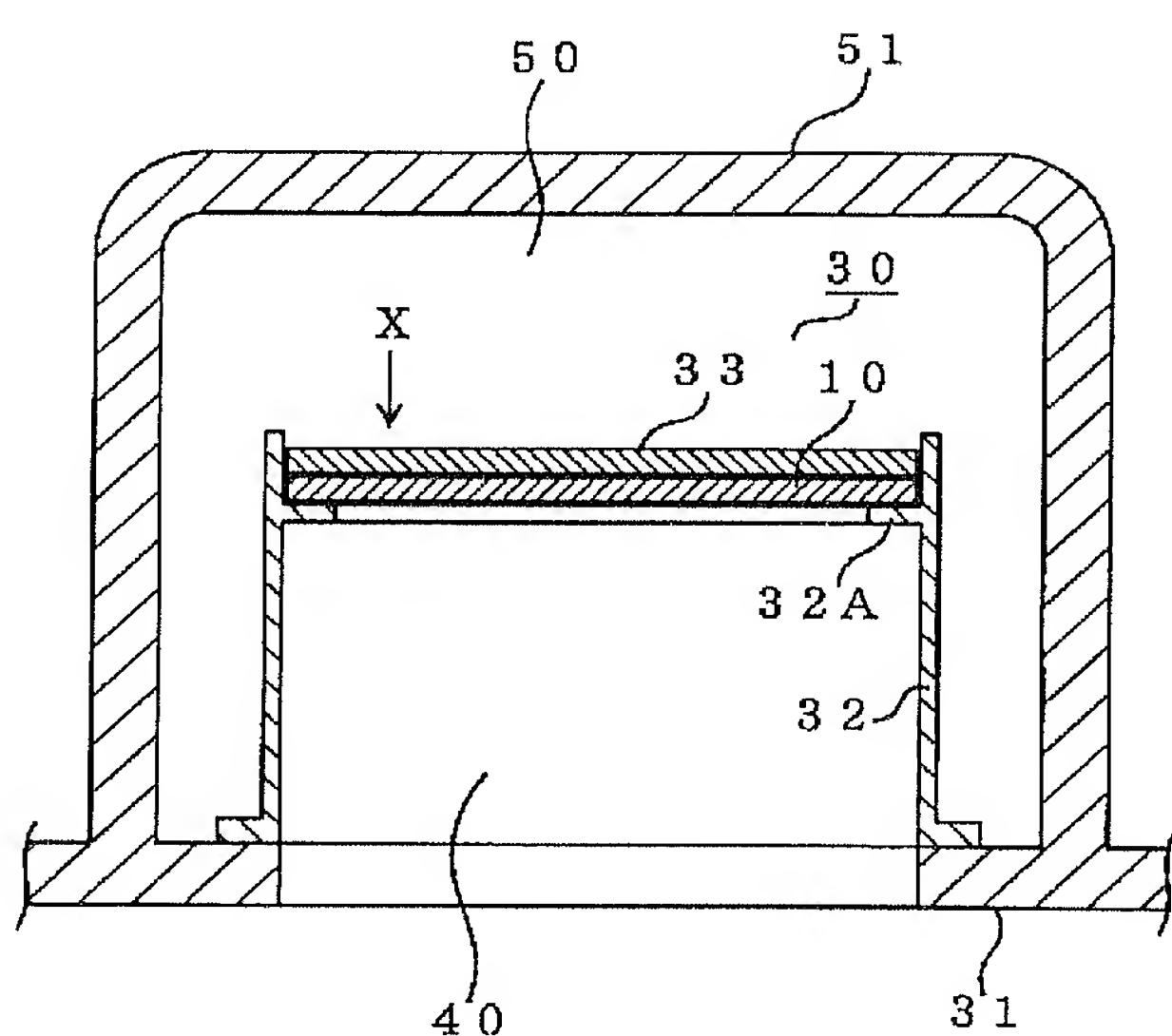
【図 3】



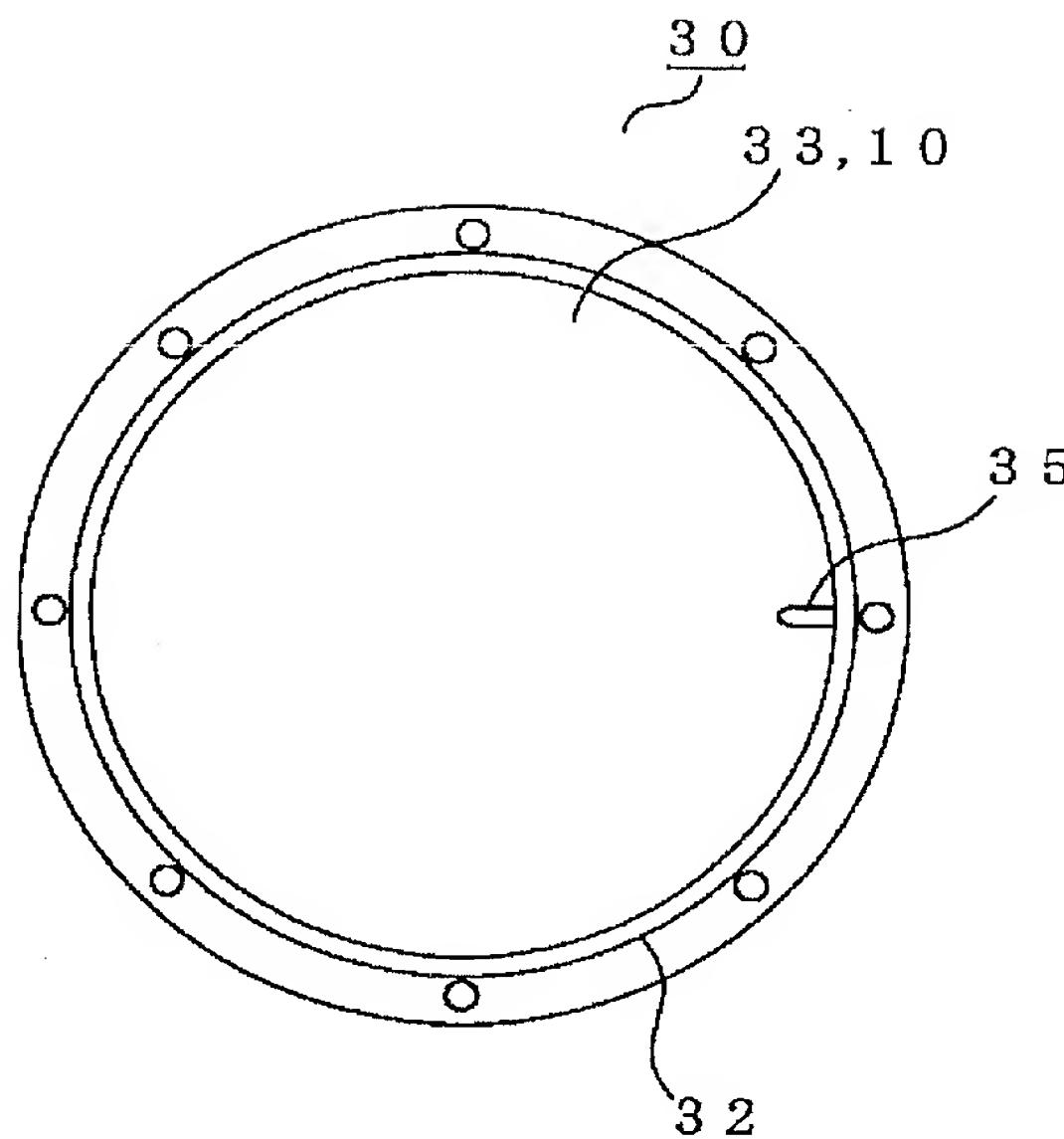
【図 4】



【図 5】



【図 6】



フロントページの続き

(51) Int. Cl.⁷

H 05 B 3/68

識別記号

F I

テーマコード (参考)

H 05 B 3/68

F ターム (参考) 3K034 AA02 AA07 AA10 AA34 AA37
 BB06 BB13 BC04 BC12 BC16
 BC23 CA02 CA26 JA10
 3K092 PP20 QA05 QB02 QB30 QB43
 QB49 QB62 QB74 QB76 QC02
 QC18 QC31 QC52 RF03 RF11
 RF17 RF22 RF26 VV22 VV40
 5F031 CA02 HA02 HA03 HA16 HA37
 PA20
 5F045 BB02 BB08 EK09 EK22 EM05
 EM09

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number : 2002-373862

(43) Date of publication of application : 26.12.2002

(51)Int.Cl.

H01L 21/205
H01L 21/68
H05B 3/10
H05B 3/20
H05B 3/68

(21)Application number : 2001-180963
(22)Date of filing : 15.06.2001

(71)Applicant : NGK SPARK PLUG CO LTD

(72)Inventor : MORITA NAOTOSHI
SAKAI SHIGEHITO

(54) CERAMIC HEATER

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a low-cost ceramic heater with the suck surface, which sucks a wafer and has a narrow temperature distribution.

SOLUTION: A ceramic heater is formed in such a structure that the heater is constituted by providing a plurality of heater layers which consist of a heater pattern 22 and a green sheet 21, a heater pattern 24 and a green sheet 23, and a heater pattern 26 and a green sheet 25 respectively.

